



Транзисторы КТ852В кремниевые планарные структуры р-п-р переключаемые. Предназначены для применения в усилителях и переключающих устройствах. Корпус пластмассовый с жесткими выводами. Масса транзистора не более 2,5 г.

Основные технические характеристики транзистора КТ852В:

Структура транзистора: р-п-р;

$P_{к т max}$ - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом: 50 Вт;

$f_{гр}$ - Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером: не менее 7 МГц;

$U_{кбо max}$ - Максимальное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера: 60 В;

$U_{эбо max}$ - Максимальное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 5 В;

$I_{к max}$ - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 2,5 А;

$I_{к и max}$ - Максимально допустимый импульсный ток коллектора: 4 А;

$I_{кбо}$ - Обратный ток коллектора - ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера: не более 1 мА (100В);

$h_{21э}$ - Статический коэффициент передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером: более 500;

$C_{к}$ - Емкость коллекторного перехода: не более 28 пФ;

$R_{кэ нас}$ - Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером: не более 1,25 Ом;

$t_{выкл}$ - Время выключения: не более 2000 нс